

期刊信息

篇名	Structure and Photoluminescence Study of InGaAs/GaAs Quantum Dots Grown via Cycled (InAs) _n /(GaAs) _n Monolayer Deposition
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Jun He*,Xiao-Dong Wang,Bo Xu,Zhanguo Wang and Sheng-Chun Qu
第一作者单位	Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
刊物名称	Jpn. J. Appl. Phys. 42-1 (3)
页面	1154-1157
出版日期	2003年 3月 日
文章标识(ISSN)	0021-4922
相关项目	1.3微米量子点激光材料及器件应用